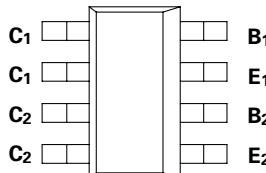


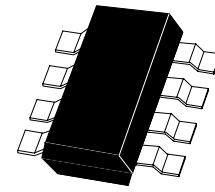
# SM-8 DUAL NPN MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTORS

ISSUE 2 - APRIL 2000

ZDT1053



PARTMARKING DETAIL – T1053



SM-8  
(8 LEAD SOT223)

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	150	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	75	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	20	A
Continuous Collector Current	$I_C$	5	A
Base Current	$I_B$	500	mA
Operating and Storage Temperature Range	$T_j;T_{stg}$	-55 to +150	°C

## THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Total Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ *	$P_{tot}$	2.25 2.75	W W
Any single die "on"			
Both die "on" equally			
Derate above $25^\circ\text{C}$ *			
Any single die "on"		18	mW/ °C
Both die "on" equally		22	mW/ °C
Thermal Resistance - Junction to Ambient*			
Any single die "on"		55.6	°C/ W
Both die "on" equally		45.5	°C/ W

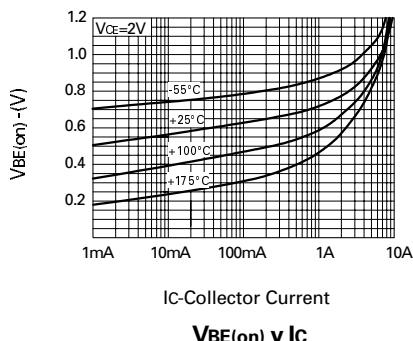
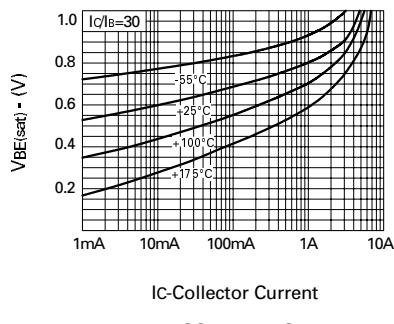
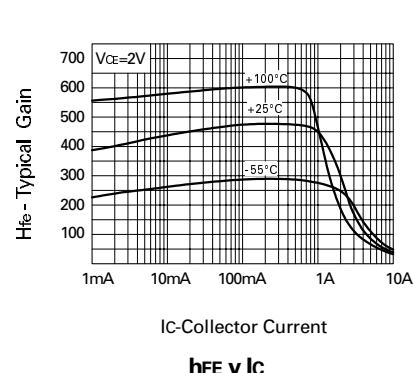
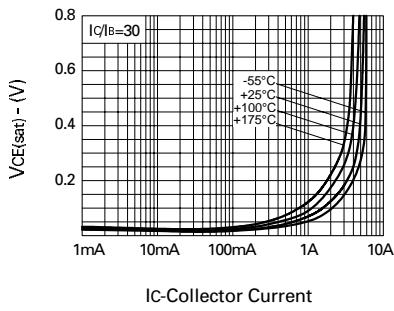
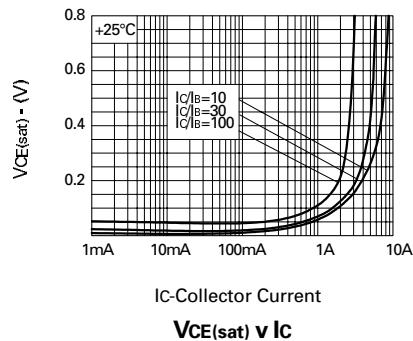
\* The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a PCB with copper equal to 2 inches square.

# ZDT1053

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	150	245		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CES}$	150	245		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	75	100		V	$I_C=10\text{mA}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEV}$	150	245		V	$I_C=100\mu\text{A}, V_{EB}=1\text{V}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	8.8		V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cutoff Current	$I_{CBO}$		0.3	10	nA	$V_{CB}=120\text{V}$
Emitter Cutoff Current	$I_{EBO}$		0.3	10	nA	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector Emitter Cutoff Current	$I_{CES}$		0.3	10	nA	$V_{CES}=120\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		17 70 120 150 300	25 100 150 200 440	mV	$I_C=0.2\text{A}, I_B=20\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}, I_B=50\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}, I_B=50\text{mA}^*$ $I_C=5\text{A}, I_B=250\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1100	1200	mV	$I_C=5\text{A}, I_B=250\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1000	1100	mV	$I_C=5\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$\text{h}_{FE}$	260 300 150 30	420 450 220 50 15	1200		$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=5\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=10\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$		140		MHz	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$ $f=100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		21	30	pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$		90		ns	$I_C=2\text{A}, I_B=20\text{mA}, V_{CC}=50\text{V}$
	$t_{off}$		750		ns	$I_C=2\text{A}, I_B=\pm 20\text{mA}, V_{CC}=50\text{V}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%

**TYPICAL CHARACTERISTICS**

**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9